DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04474526 **Image available** LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.: **06-118426** [JP 6118426 A]

PUBLISHED: April 28, 1994 (19940428)

INVENTOR(s): YAMADA YUMIKO

TANAKA YASUHARU

HISATAKE YUZO

APPLICANT(s): TOSHIBA CORP [000307] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

04-270649 [JP 92270649]

FILED:

October 09, 1992 (19921009)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/1343

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD:R004 (PLASMA); R011 (LIQUID CRYSTALS); R096

(ELECTRONIC

MATERIALS -- Glass Conductors); R119 (CHEMISTRY -- Heat

Resistant Resins)

JOURNAL:

Section: P. Section No. 1777, Vol. 18, No. 402, Pg. 87, July

27, 1994 (19940727)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain a liquid crystal display device in which the non-uniformity or lowering of a contrast ratio can be prevented from occuring even when it is displayed for a long time and satisfactory display characteristic with a wide visual angle and high contrast can be obtained.

CONSTITUTION: A lateral electric field electrode 15 is arranged adjacently to one side 14a of an electrode 14 to form picture element electrodes 14 arranged in matrix shape in two areas A, B with different tilting directions of a liquid crystal molecule. and reverse tilt is generated by a lateral electric field at a part of the area for normal tilt decided by the orientation of orientation film 19, 23. The boundary of different tilt areas can be decided by an auxiliary capacitor (Cs) line 16 which bisects the picture element electrode.

Family list 2 family member for: JP6118426 Derived from 1 application.

No English title available
Publication info: JP3208189B2 B2 - 2001-09-10
JP6118426 A - 1994-04-28

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-118426

(43)公開日 平成6年(1994)4月28日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

G02F 1/1343

9018-2K

零査請求 未請求 請求項の数1 (全7頁)

(21)出顧番号

特顧平4-270649

(22)出顧日

平成4年(1992)10月9日

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 山田 ゆみ子

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社束芝横浜事業所内

(72)発明者 田中 康晴

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内

(72)発明者 久武 雄三

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社束芝横浜事業所内

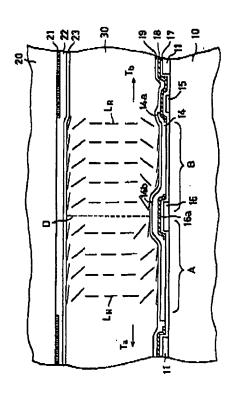
(74)代理人 弁理士 大胡 典夫

(54) 【発明の名称】液晶表示装置

(67)【要約】

【構成】 マトリクス状に配置された国素電極14のそれぞれを液晶分子のチルト方向の異なる2 傾域A、Bに形成するために、電極14の1辺14 aに隣接して模電界発生電極15を配置し、配向膜19、23の配向によってきまるノーマルチルトに対して、その領域の一部に模電界によってリバースチルトを生じさせる。異なるチルト領域の境界は画案電極を2分する補助容量(Cs)線16によって固定する。

【効果】 長時間表示してもコントラスト比の不均一や 低下が発生せず、視野角の広い良好な表示特性で高コン トラストの液晶表示装置を得ることができる。



特開平6-118426

【特許請求の範囲】

【請求項1】 行方向および列方向にそれぞれ配列形成される複数本の走査線および複数本の信号線と、マトリクス状に配置され前配走査線および信号線により制御される能勤案子およびこれに接続される画素電極が形成され、前配画案電極を覆うように形成された配向膜を具備したアレイ基板と、前配画素電極と対向して置かれる共通電極上に形成された配向膜を具備した対向基板を備え、前配アレイ基板と対向基板の間隙に配設され前配配向膜により液晶分子が所定の角度および方 10向にプレチルトされる被晶層とを具備した液晶表示装置において、前配液晶分子のプレチルト角発生すると反対方向の画素電極外周に隣接して横電界発生電極を設けたことを特徴とする液晶表示装置。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は液晶表示装置に係り、 特にTN型の液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、薄型軽量、低消費電力という大き 20 な利点をもつ液晶表示装置は、日本語ワードプロセッサ、デスクトップパーソナルコンピュータ等のパーソナルOA機器の表示装置や、テレビ等の映像表示装置として積極的に用いられている。特に、アクティブマトリクス型の液晶表示装置は、高解像度の表示が実現できることから、開発が盛んに行われている。

【0003】従来のアクティブマトリクス型の液晶表示 装置のアレイ基板は、絶縁性基板の一主面上に行方向に 複数本の走査線および列方向に複数本の信号線が配列形成され、前配走査線および信号線の交差位置に薄膜トラ 30 ンジスタ (以下TFTと略す) およびこれに接続される 国素電極からなる一国素が形成され、その上に配向膜が形成されている。一方、上部の対向基板は絶縁性基板の一主面上に共通電極が形成され、その上に配向膜が形成されている。アレイ基板と対向基板を前述の電極が形成されている主面を対峙させ、間隙に液晶剤を挟持させている。通常、アレイ基板側と対向基板側では90度ずれた方向に配向膜を配向処理してあるため、液晶分子が厚さ方向に90度捩じれて並ぶTN型液晶が使われている。

【0004】 TN型の液晶表示装置は、見る方向によってコントラスト比や表示色が変化するという視野角依存性がある。従来の液晶表示装置の視野角依存性を測定したデータの一例を図6に示す。基板表面の正対位置を基準に、上下方向に観察方向を変えたときの特性で視野角のすなわち視点の角度 θ に対してコントラスト比は対称にならない。一般に視点の角度 θ によりコントラスト比が大きく変化するが、角度 θ がマイナスに扱れると表示色の反転が起こるので、観察位置に制限がある。

【0005】このような視野角依存性を改善するため、

種々の技術が提案されているが、そのほとんどが、配向 処理に関するものである。例えば、特開昭63-106624 **号** 公報、特開昭64-88520号公報、特開平1-245223号公報で は各国索を複数の領域に分割し、それぞれの領域の配向 方向が異なるように配向処理をすることによって、視野 角依存性を改善している。このような配向処理の手法に ついて、例えば、特開昭60-211421 号公報、特開昭60-2 11422 号公報、特開昭60~211428 号公報、特開昭60~211 424 号公報に記載されているが、プロセスが非常に複雑 になり、生産性が低いという問題点がある。また、TN 液晶用の配向膜として一般に普及しているポリイミドは 所定のパターンにエッチングするのが難しく、前述のよ うな配向処理が異なる領域を作製することができない。 従って、画案を分割して配向方向が異なる領域を得るに は、保持率やプレチルト角等、液晶表示装置の配向膜と しての信頼性が高いポリイミドを使用し難いため、配向 膜としての特性とパターニング容易性を兼ね備えた新し い配向膜が必要となるが、これ以上に適した部材はまだ 現れていないのが現状である。

【0006】ところで、 画素電極の周囲にはパスラインが形成されているため、パスラインからの横方向電界によりプレチルトの方向とは異なる方向に被晶分子が立ち上がるチルトリバースという現象が生じ易い。このチルトリバースは正常なチルト領域との境界にディスクリネーションラインが発生し、パスラインの電圧によって変動するので、 画質の不良として通常ブラックマトリクスで覆い隠されている。 また、チルトリバース領域の発生を防止するための提案が多数なされているが、完全に解消するに至っていない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上述のように従来の液 晶表示装置においては、視野角依存性があり、良好な画 像が得られないという問題点があった。

【0008】本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたものであり、広範囲の視野角において良好な 画質が得られる液晶表示装置を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、行方向および 利方向にそれぞれ配列形成される複数本の走査線および 複数本の信号線と、マトリクス状に配置され前記走査線 および信号線により制御される能動案子およびこれに接 続される画案電極が形成され、前記回素電極を置うよら に形成された配向膜を具備したアレイ基板と、前記の三 電極と対向して置かれる共通電極と前記共通電極上に形 成された配向膜を具備した対向基板を備え、前記アレイ 基板と対向基板の間隙に配設され前記配向膜により液晶 分子が所定の角度および方向にプレチルトされる液晶層 とを具備した液晶表示装置において、前記液晶のプ レチルト角発生方向と反対方向の画素電極外周に隣接し

特開平6-118426

3 て模電界発生電極を設けたことを特徴とする液晶表示装 歴にある。

【0010】本発明の機電界発生電極は、画素電極との間に横方向電界を発生させ、液晶分子のプレチルトの方向とは異なる方向にチルト角を与えるためのもので、異なる方向にチルト角を付与される領域をリバースチルト領域とする。加える電極は必要とされるリバースチルト領域の大きさにより適宜決定すればよい。

【0011】本発明のプレチルト角発生方向は配向膜により液晶分子に与えられるチルト角の方向であり、画索 10 電極と共通電極により均一な電界が与えられた場合に、 被晶分子が立ち上がる方向である。

[0012]

[0013]

【実施例】以下本発明の実施例について述べる。

【0014】 (実施例1) 図1および図2は本発明の実 施例を示し、ガラスでなる下部の基板10には、複数の 平行な走査線11と信号線12が交差して形成され、交 差部には能助スイッチング索子としてTFT13が形成 されている。平行するそれぞれ2本の走資線11と信号 線12で区画する領域には画素電極14が形成されてマ 30 トリックス状に配置されTFT13に接続されている。 **國索電極14の矢印Rで示すラピング方向の進入側の外** 周辺14aと走査線11の間には、走査線11に平行に ストライプ状の横電界発生電極15が形成されている。 この機電界発生電極15は任意の電圧が印加可能に形成 される。さらにこの機電界発生電極15に平行にしかも 画素電極14の下地でこの画素電極を2分する位置に補 助容量線 (Cs 線) 16を配置する。機能界発生電極 1 5の上に、走査線11と信号線12の間の層間絶縁膜と なる酸化けい素層 (SiOx)層17,窒化けい素層 (SiNx)層18が形成され、この上に更に配向膜1 9が形成される。

【0015】一方、上部のガラス基板20にはブラックマトリクス21および共通電極22が形成され、更に配向膜23が形成される。ブラックマトリクス21は走査線、信号線からなるパスラインと、画素電極14の端部とを硬うように配置される。これら2枚の基板の間隙には液晶層30が挟持される。

【0016】動作時は、共通電極22を基準にして國素 形成 電極14に例えば3V、機電界発生電極15に例えば1 50 る。

Vが印加されると、図のように液晶分子LR が横電界発生電極15と画楽電極14の間の横電界によりチルト角を制御させて、画楽電極14のラピンク進入方向側の辺14aの領域は矢印Tb 方向にチルト角が生じリパースチルト領域Bとなる。

【0017】一方、ラピング進行方向側は模電界の影響がなく液晶分子LNは配向膜の配向方向にしたがいチルト角発生方向はTbであり、ノーマルチルト領域Aのまま保持される。このため2つの領域の境界にはディスクリネーションラインDやウォールができる。ブラックマトリクス層16aを有するCs線16はこのディスクリネーションラインDを隠すようにが配置される。

【0018】このようにリパースチルト領域Bとノーマルチルト領域Aが一つの国素内に形成されるため、視野角依存性が低減され、良好な画像を得ることができるようになる。

【0019】次に本実施例の製造方法について説明する。

【0020】まず下部のアレイ基板10は、ガラス等の 絶縁透明材料からなる基板上に、スパッタリング法でM oTa合金等の金属膜を250nm成膜後、パターニン グ、ケミカリドライエッチング法CDEによりエッチン グし、所定の形状の10μm幅のCs 練16および8μ m幅の走査線11、ゲート電極13G、8μm幅の機電 界発生電極15を形成する。次に、SIOx 層17をプ ラズマCVD法により350nm、a-Si膜(図示せ ず)、SINx層18をプラズマCVD法でそれぞれ5 0 nm, 200 nm形成し、S1Nx 層を弗酸系のエッ チング液がエッチングし、TFTのチャネル保護層(図 示せず)を形成する。オーミックコンタクトとなるよう にするためn'a-Si膜(図示せず)をプラズマCV D法により50nm成膜する。CDEによりn'a-S i膜、a-Si膜、SiNx 層18をエッチングし、所 定の形状にする。

【0021】スパッタリング法でCr. Alをそれぞれ 50 nm, 500 nm積層して成膜し、パターニングとして硝酸燐酸酢酸混合溶液および硝酸セリウムアンモニウム溶液で、Cr. Alをそれぞれエッチングし、8μ m幅の信号線12、ソース電極13S、ドレイン電極13Dを形成する。ソース電極13Sとドレイン電極13Dの間に酵出したn a-Sl膜をソース電極13S、ドレイン電極13Dをマスクにして、CDEでエッチング、除去する。更にITO(インジウム鰯酸化物)などの透明導電膜を100 nmスパッタ法で形成し、パターニングし、王水系エッチング液でエッチングし65μm×65μmの短形状の画衆電極5を形成する。パッシベーション膜(図示せず)としてSINxを200 nm成膜する。更に、配向膜用にポリイミド簙膜を100 nm形成した後、この配向膜19の表面をラビング処理す

特開平6-118426

5

【0022】この結果、画素電極14の一辺148の簡 緑が横電界発生電極15に対して、絶縁層17、18を 隔ててその上面に重なるように配置される。また、画素 **電極を2分する中央にCs 線16の厚みによる突状リッ** ジ16 bが形成される。このリッジ16 bはリパースチ ルト領域Bとノーマルチルト領域Aの境界を形成しやす くするもので、横電界を発生したときに、このリッジと 横電界発生電極間の画業電極領域を配向膜19のチルト 方向(傾域A)とは異なるリバースチルト状態にする。

【0023】一方、上部の基板20は、ガラス等の絶縁 10 透明材料からなり、その上にプラックマトリクス21と なるCr等の金属膜を300nmスパッタ法で形成し、 フォトリソグラフィで格子状にパターニングする。透明 導電膜を100mmスパッタ法で形成し、共通電極22 とする。更に、ポリイミド薄膜を100mm形成した 後、配向膜23の表面をラピング処理を行う。

【0024】この後、アレイ基板10の配向膜19の周 辺に沿って接着剤としてエポキシ系接着剤を注入口(図 示せず)を除いて印刷した。次にアレイ基板の表面に問 腺材(図示せず)として粒径5μmの微細球(積水ファ 20 インケミカル社製のミクロパール (商品名)) を散布し た。次に配向膜19、23が対向し、またそれぞれのラ ピング方向が90度となるよう上下の基板を配置し、加 熱して接着剤を硬化させ両基板10、20を貼り合わせ た。

【0025】次に選常の方法により注入口より液晶材と して、ZLI-1565 (E. メルク社製) にS811 (E. メルク社製) を 0. 1 w t %添加したものを注入 し5μm厚の液晶層30とし、この後注入口を紫外線硬 化樹脂で封止した。

【0026】さらにこの後上下の基板に偏光板を貼り合 わせ、アクティブマトリクス型液晶表示装置を作製し た。

【0027】このようにして作製した本発明による液晶 表示装置の視野角依存性を調べたところ、図3に示すよ うな良好な結果が得られた。すなわち図3は基板垂直方 向を基準にして観察方向に傾いた角度を視野角 θ とした ときの、コントラスト比を示すもので、上方、下方とも にほぼ対称的なコントラスト比が得られることが分か

【0028】 (実施例2) 図4は本実施例の液晶表示装 聞を示し、図2と同一符号は同様な部分を示す。図に示 すように下部のアレイ基板10には、走査線11と國素 電極14の間に横電界発生電極15が形成される。横電 界発生電極15は機能界発生電極15と信号線12の間 の層間絶縁膜となるSiOx 層27, SINx 層28上 に形成され画業電極14の周繰14aよりも上面に配置 される。

【0029】SIOx 暦27、SINx 層28および横 電界発生電極15は次のようなプロセスで形成される。 50 【0039】

SIOx 層27はプラズマCVD法により350nm、 SiNx 層28はプラズマCVD法でそれぞれ200n m形成し、CDEによりSIOx 層27、SINx 層2 8をエッチングし、所定の形状にする。 さらに、スパッ タリング法でCr. Alをそれぞれ50nm, 500n m積層して成膜し、パターニングとして硝酸燐酸酢酸湿 合溶液および硝酸セリウムアンモニウム溶液で、Cr. Alをそれぞれエッチングし模電界発生電極15を形成 する.

【0030】このように、横電界発生電極15が画素館 極の辺部分14aよりも上面に位置するので、国森電極 14の領域と対向基板の電極22との間に形成される電 界に、基板に平行な機電界成分を付与しやすく、小電界 でリパースチルト領域Bを形成できる。

【0031】 (実施例3)以下第3の実施例について述

【0032】図5は本実施例の液晶表示装置の実施例で 図2と同一符号は同様な部分を示す。

【0033】図に示すようにアレイ基板10には、走査 線11で挟むように画業電極14が形成され、走査線1 1と画素電極14の間には横電界発生電極15が形成さ れている。一方、対向基板20にはブラックマトリクス 21と共通電極22が形成されているが、共選価板22 の機電界発生電極15に対応する位置は切り欠き部22 aとなっている。このように横電界発生電極15上の共 邇電極を取り除くことにより、横電界を強く発生させる ことができる。

【0034】更に、本実施例では共通電板22のCs 線 16に対応する位置は切り欠き部22bとなっている。 このようにCs 線16上の共通電極を取り除くことによ り、安定にリバースチルト領域日を形成することができ

【0035】本発明で用いられる配向膜はどの様なもの であってもよいが、プレチルト角が低いものが好まし く、1度以下が望ましい。プレチルト角が1度以下の場 合、横電界発生電極に加える電圧が低くてもチルトリバ 一ス領域を広くすることが可能である。

【0036】プロジェクター用の液晶表示装置等、一画 素が小さい場合には要求されるチルトリバース領域の大 40 きさが小さくなるため、横電界発生電極に加える電圧が 低くても視野角を良好にすることができる。

【0037】また、本発明の機電界発生電極は画素電極 のラピング進入方向近傍に形成されるものであり、形 状、材質などはチルトリパース領域が所定の範囲となる よう適宜決定すれば良い。

【0038】本発明のチルトリバース傾城の範囲は視野 角をどの様に設計するかにより、決定されるものであ り、ノーマルチルト領域とチルトリパース領域の比は1 対1に限定されるものではない。

(5)

特開平6-118426

8

【発明の効果】本発明によれば、長時間表示してもコントラスト比の不均一や低下が発生せず、視野角の広い良好な表示特性で高コントラストの液晶表示装置を得ることができる。

7

SEL

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による一実施例の一基板の概略平面図、

【図2】図1を1~Ⅰ線に沿って切断して示す概略断面 図

【図3】本発明による一実施例の視野角 θ とコントラスト比の特性を表す図、

【図4】本発明による他の実施例の一基板の級略断面図、

【図 6 】本発明による他の実施例の一基板の概略断面 図、

【図 6 】 従来の液晶表示装置の視野角 θ とコントラスト 比の特性を表す図。

【符号の説明】

10…アレイ基板11…走査線12…信号線13…TFT

14…画素電極 15…機電界発生電極

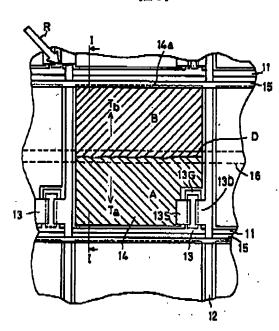
16…補助容量線 (Cs線)

10 20…対向基板 30…液晶層

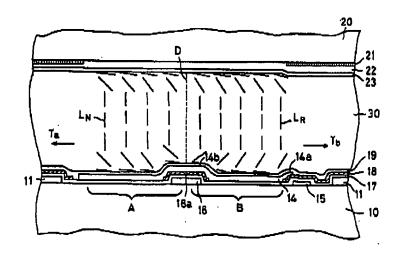
A…ノーマルチルト領域 B…リパースチルト領域

D…ディスクリネーションライン

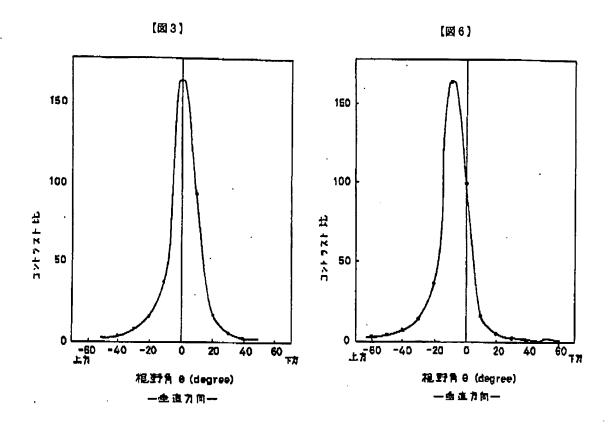
【図1】

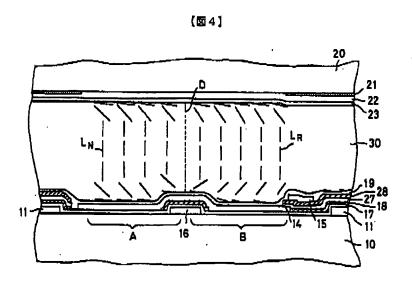


【図2】



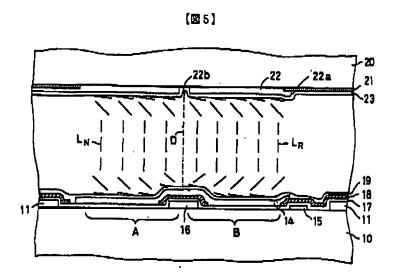
SEL





(7)

特開平6-118426



特開平8-118426

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第8部門第2区分 【発行日】平成13年1月12日(2001.1.12)

【公開番号】特開平8-118428 【公開日】平成8年4月28日(1994.4.28) 【年通号数】公開特許公報8-1185 【出顾番号】特願平4-270648 【国際特許分類第7股】 GO2F 1/1343 (F !)

GO2F 1/1343

【手続補正誊】

【提出日】平成11年10月6日(1999.10. 8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【捕正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 行方向および列方向にそれぞれ配列形成 される複数本の走査線および複数本の信号線と、マトリ クス状に配置され前記走査線および信号線により制御さい れる能動素子およびこれに接続される国素電極が形成さ れ、前記画素電極を覆うように形成された配向膜を具備 したアレイ基板と、前配画素電極と対向して置かれる共 過電極と前記共通電極上に形成された配向膜を具備した 対向基板を備え、前記アレイ基板と対向基板の間隙に配 設され前記配向膜により液晶分子が所定の角度および方

向にプレチルトされる液晶層とを具備した液晶表示装置 において、各国素質極内の一部領域に対応する液晶分子 の立ち上り方向もしくは立ち下がり方向を前配一部領域 以外の領域と異なるように制御する横電界発生電極を有 するととを特徴とする液晶表示装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正内容】

[0001]

【塵業上の利用分野】との発明は液晶表示装置に関す

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011 ·

【補正方法】削除